【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成23年12月15日(2011.12.15)

【公開番号】特開2010-199187(P2010-199187A)
【公開日】平成22年9月9日(2010.9.9)
【年通号数】公開・登録公報2010-036
【出願番号】特願2009-40535(P2009-40535)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ　21/60　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　21/60　　３１１Ｓ

【手続補正書】
【提出日】平成23年11月1日(2011.11.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
半導体基板上に突起電極を形成する工程と、
前記半導体基板上に接着膜を形成する工程と、
を備え、
前記半導体基板上に前記接着膜を形成する工程では、前記接着膜を加熱した状態で前記接着膜に対して圧力を加えることにより前記接着膜を半導体基板に接着するとともに、前記突起電極の上部を前記接着膜から露出させる
ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
前記半導体基板上に形成された前記接着膜を配線基板に接着する工程を更に備え、
前記接着膜を前記配線基板に接着する工程では、前記接着膜を加熱した状態で前記接着膜に対して圧力を加えることにより前記接着膜を前記配線基板に接着する
ことを特徴とする請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
前記接着膜は、加熱することで軟化し外力により変形容易であり、冷却することで硬化し冷却時の形状を維持する
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の半導体装置の製造方法。